Mega16熔丝位相关

一. 熔丝位介绍

ATmega16有两个熔丝位字节。Table 1 - Table 2简单地描述了所有熔丝位的功能以及他们是如何映射到熔丝字节的。如果熔丝位被编程则读返回值为"0"。

| 熔丝位高字节 | 位号 | 描述 | 默认值 |
|----------|----|---------------------|----------------------|
| OCDEN | 7 | 使能 OCD | 1. (未编程, OCD 禁用) |
| JTAGEN | 6 | 使能 JTAG | 0(编程,JTAG 使能) |
| SPIEN | 5 | 使能串行程序和数据下载 | 0(被编程,SPI 编程使能) |
| СКОРТ | 4 | 振荡器选项 | 1 (未编程) |
| EESAVE | 3 | 执行芯片擦除时 EEPROM 的内容保 | 1(未被编程),EEPROM 内容不保留 |
| | | 留 | |
| BOOTSZ1 | 2 | 选择 Boot 区大小 | 0 (被编程) |
| BOOTSZ0 | 1 | 选择 Boot 区大小 | 0 (被编程0) |
| BOOTRST | 0 | 选择复位向量 | 1 (未被编程) |
| 熔丝位低字节 | 位号 | 描述 | 默认值 |
| BODLEVEL | 7 | BOD 触发电平 | 1 (未被编程) |
| BODEN | 6 | BOD 使能 | 1 未被编程,BOD 禁用) |
| SUT1 | 5 | 选择启动时间 | 1(未被编程) |
| SUT0 | 4 | 选择启动时间 | 8 (被编程) |
| CKSEL3 | 3 | 选择时钟源 | 0(被编程) |
| CKSEL2 | 2 | 选择时钟源 | 0 (被编程) |
| CKSEL1 | 1 | 选择时钟源 | 0(被编程) |
| CKSEL0 | 0 | 选择时钟源 | 1 (未被编程) |



http://www.mcustudio.com.cn 厦门智控

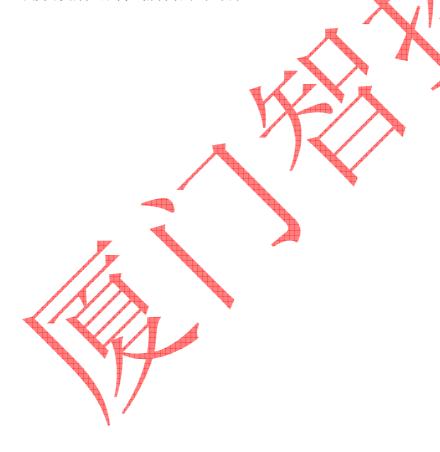
二. 时钟源选择

ATmega16芯片有如下几种通过 Flash 熔丝位进行选择的时钟源。时钟输入到 AVR 时钟发

生器,再分配到相应的模块。

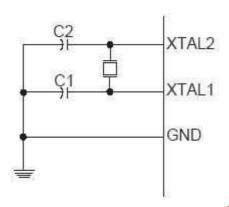
| 器件时钟选项 | CKSEL30 |
|--------------|-----------|
| 外部晶体/陶瓷振荡器 | 1111-1010 |
| 外部低频晶振 | 1001 |
| 外部 RC 振荡器 | 1000-0101 |
| 标定的内部 RC 振荡器 | 0100-0001 |
| 外部时钟 | 0000 |

Note: 1.对于所有的熔丝位, "1"表示未编程, "0"代表已编程。 缺省时钟源: 器件出厂时 CKSEL = "0010", SUT = "10"。这个缺省设置的时 钟源是1 MHz 的内部 RC 振荡器,启动时间为最长。这种设置保证用户可以通过 ISP 或并行编程器得到所需的时钟源。



http://www.mcustudio.com.cn 厦门智控

三.晶体振荡器晶体振荡器连接如图:



振荡器可以工作于三种不同的模式,每一种都有一个优化的频率范围、工作模式通过熔丝

位 CKSEL3..1来选择:

晶体振荡器工作模式:

| СКОРТ | CKSEL31 | 频率范围(MHz) | 使用晶体时电容 C1和 C2的推荐范围(pF) |
|-------|---------------|-----------|-------------------------|
| 1 | 101 | 0.4-0.9 | |
| 1 | 110 | 0.9-3.0 | 12-22 |
| 1 | 111 | 3.0-8.0 | 12-22 |
| 0 | 101, 110, 111 | 1.0 | 12-22 |

熔丝位 CKSEL0以及 SUT1..0用于选择启动时间。

晶体振荡器时钟选项对应的启动时间:

| CKSEL0 | SUT1.0 | 掉电与节电模式下 | 复位时额外的延迟时 | 推荐用法 |
|--------|--------|----------|-----------|---------------|
| | | 的启动时间 | 间() | |
| | | | FI () | |
| 0 | 00 | 258CK | 4.1ms | 陶瓷谐振器,电源快速上升 |
| 0 | 01 | 258CK | 65ms | 陶瓷谐振器,电源缓慢上升 |
| 0 | 10 | 1K CK | _ | 陶瓷谐振器, BOD 使能 |
| 0 | 11 | 1K CK | 4.1ms | 陶瓷谐振器,电源快速上升 |
| 1 | 00 | 1K CK | 65ms | 陶瓷谐振器,电源缓慢上升 |
| 1 | 01 | 16K CK | _ | 石英振荡器, BOD 使能 |
| 1 | 10 | 16K CK | 4.1ms | 石英振荡器, 电源快速上升 |
| 1 | 11 | 16K CK | 65ms | 石英报警器, 电源慢速上升 |

四. 程序及数据存储器锁定位

ATmega16提供了6个锁定位,根据其被编程("0")还是没有被编程("1")的情况可以获得列出的附加性能。锁定位只能通过芯片擦除命令擦写为"1"。

| 锁定位字节 | 位号 | 描述 | 默认值 |
|-------|----|----------|---------|
| | 7 | ı | 1 (未编程) |
| | 6 | | 1(未编程) |
| BLB12 | 5 | Boot 锁定位 | 1 (未编程) |
| BLB11 | 4 | Boot 锁定位 | 1 (未编程) |

http://www.mcustudio.com.cn 厦门智控

| BLB02 | 3 | Boot 锁定位 | 1 (未编程) |
|-------|---|----------|---------|
| BLB01 | 2 | Boot 锁定位 | 1 (未编程) |
| LB2 | 1 | 锁定位 | 1(未编程) |
| LB1 | 0 | 锁定位 | 1 (未编程) |

锁定位保护模式

| 存储器锁定位 | | | 保护类型 |
|--------|-------|-------|-----------------------------|
| LB 模式 | LB2 | LB1 | |
| 1 | 1 | 1 | 没有使能存储器保护特性 |
| 2 | 1 | 0 | 在并行和 SPI/JTAG 串行编程模式中 |
| | | | Flash 和 EEPROM 的进一步编程禁止, |
| | | | 熔丝位被锁定。 |
| 3 | 0 | 0 | 在并行和 SPI/JTAG 串行编程模式中 |
| | | | Flash 和 EEPROM 的进一步编程及验 |
| | | | 证被禁止,锁定位和熔丝位被锁定 |
| BLB0模式 | BLB02 | BLB | |
| | | 01 | |
| 1 | 1 | 1 | SPM 和 LPM 对应用区的访问没有限 |
| | | | 制 |
| 2 | 1 | 0 | 充允许 SPM 对应用区进行写操作 |
| 3 | 0 | 0 | 木允许 SPM 指令对应用区进行写操 |
| | | _ / / | 作,也不允许运行于 Boot Loader 区的 |
| | | | LPM 指令从应用区读取数据。若中断 |
| | | | 向量位于 Boot Loader 区, 那么执行应 |
| | | | 用区代码时中断是禁止的。 |
| 4 | 0 | 1 | 不允许运行于 Boot Loader 区的 LPM |
| | | | 指令从应用区读取数据。若中断向量 |
| | | | 位于 Boot Loader 区,那么执行应用区 |
| | | | 代码时中断是禁止的。 |
| BLB1模式 | BLB12 | BLB | |
| | | 11 | |
| 1 | 1 | 1 | 允许 SPM/LPM 指令访问 Boot Loader |
| | | | 区 |
| 2 | i i | 0 | 不允许 SPM 指令对 Boot Loader 区进 |
| | 1 | | 行写操作 |
| 3 | 0 | 0 | 不允许 SPM 指令对 Boot Loader 区进 |
| | | | 行写操作,也不允许运行于应用区的 |
| | | | LPM 指令从 Boot Loader 区读取数据。 |
| | | | 若中断向量位于应用区,那么执行 |
| | | | Boot Loader 区代码时中断是禁止的。 |
| 4 | 0 | 1 | 不允许运行于应用区的 LPM 指令从 |
| | | | Boot Loader 区读取数据。若中断向量 |
| | | | 位于应用区,那么执行 Boot Loader 区 |
| | | | 代码时中断是禁止的。 |